

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形トランジスタ

2SA695

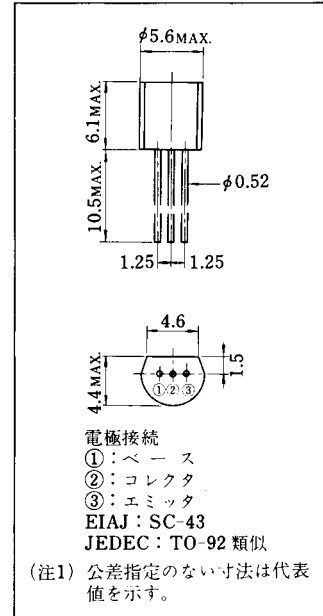
低周波電力増幅用

- コレクタ損失が大きい ($P_C=500\text{mW}$)。
- 大電流での h_{FE} の低下が少ない ($I_C=-700\text{mA}$)。
- 2SC1209 とコンプリメンタリで使用するのに最適です。

最大定格 (周囲温度 25°C)

項 目	記 号	定 格 値	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-25	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-4	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-20	V
せん頭コレクタ電流	I_{CM}	-1000	mA
コレクタ電流	I_C	-700	mA
コレクタ損失	P_C	500	mW
接合部温度	T_j	+125	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+125	$^\circ\text{C}$

外形図 単位: mm

電気的特性 (周囲温度 25°C)

項 目	記 号	測 定 条 件	最 小	標 準	最 大	単 位
コレクタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C = -10\mu\text{A}, I_E = 0$	-25	—	—	V
エミッタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = -10\mu\text{A}, I_C = 0$	-4	—	—	V
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -100\mu\text{A}, R_{BE} = \infty$	-20	—	—	V
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -25\text{V}, I_E = 0$	—	—	-1	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -2\text{V}, I_C = 0$	—	—	-1	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE} = -1\text{V}, I_C = -500\text{mA}$ (パルス)	55	100	300	—
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -500\text{mA}, I_E = -25\text{mA}$	—	—	-0.5	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE} = -6\text{V}, I_E = 10\text{mA}$	—	150	—	MHz

h_{FE} の値により下表のようにアイテム分類を行なっています。

アイテム	C	D	E
h_{FE}	55~110	90~180	150~300